DEVELOPMENT OF THE SHORT-PERIOD AND SHORT-GAP UNDULATORS FOR THE 2.5GEV PHOTON FACTORY STORAGE RING

Shigeru Yamamoto^{A, B, C)}, Kimichika Tsuchiya^{A)}, Hiroyuki Sasaki^{A)}, and Tatsuro Shioya^{A)}

^{A)} Photon Factory, High Energy Accelerator Research Organization, KEK

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801

^{B)} Department of Materials Structure Science, The Graduate University for Advanced Studies 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801

^{C)} Department of Photoscience, The Graduate University for Advanced Studies

Shonan Village, Hayama, Kanagawa 240-0193

Abstract

A very short-period and in-vacuum type undulator, SGU#17 has been constructed and installed in the 2.5GeV Photon Factory storage ring, which has been upgraded to enhance the straight sections for insertion devices in the PF ring. SGU#17 is designed to be a hard x-ray source for protein crystallography and structural biology.

PHOTON FACTORY 2.5GeV リングのための短周期アンジュレータの開発

1. PF直線部改造と短周期アンジュレータ

高エネルギー加速器研究機構・放射光研究施設 (KEK-PF)では、これまで2.5GeV電子蓄積リング の直線部改造を行ってきた[1]。この改造の目的は、 1997年に行った高輝度化改造で達成した低エミッタ ンスを保ちつつ、光軸不変のまま、直線部の新設お よび既存直線部の拡張を行うことである。例えば、 鉛直方向について0.5m以下のβ関数を実現可能な 1.4m直線部が4本新設される。また、B01-02間、およ びB15-16間の5.0m直線部が9.2mに伸長される。これ らの1.4m短直線部は、そこに短周期のアンジュレー タ(Short Gap Undulator: SGU)を設置し、X線領域 のアンジュレータ光をPF2.5GeVリングにおいて利用 可能にできるという点で、非常に重要である。 用いても、図1に示したように10mm程度の非常に短い周期長のアンジュレータを使用すれば、アンジュ レータの低次高調波によって15keV程度の硬X線領域 のアンジュレータ放射を得ることは可能である。し かし、この状況を実現するには十分に強いアンジュ レータ磁場を実現するために、アンジュレータの磁 石間ギャップを5mm程度以下の非常に狭い値に設定 することが必要になる。このことは、最近KEK-PFや その他の第三世代放射光施設において多用されるよ うになった、真空封止型アンジュレータの技術[2]と 最新の加速器ラティス設計法との組合わせによって 初めて可能となる[3]。図2は、1.4m短直線部の新設 (図2a.および2b.) とそこにおける光学関数(図 2c.)を図解している。



図1. PFリングに新設された1.4m直線部に設置可 能な短周期アンジュレータの予測されるスペクトル。 周期長12mm, 16mmおよび20mmについて,低次高 調波のピーク位置の軌跡を示している。

2.5GeVという比較的低い電子ビームエネルギーを



図2a.および2b. 1.4m直線部の新設。

FO09



図2c. PFリングに新設された1.4m直線部におけ る光学関数。鉛直方向β関数の設計値は0.4mである。

2. 短周期アンジュレータの開発

2005年夏に完了したPFの直線部改造によって偏向 電磁石B16-17間(この他,B02-03間,B14-15間,お よびB28-01間)に新設された1.4m直線部では,鉛直 方向 β 関数を0.4mに設定することが可能になった。 我々は、この直線部に最小ギャップ4.5mmの真空封 止型短周期アンジュレータ(SGU#17)を建設・設置 した[4]。SGU#17の建設において,我々は周期長 (λ) 12mmおよび16mmの2組の磁石配列(Halbach 型)について短周期磁気回路の研究開発を行った。 磁気回路に許容される長さから λ =12mmについては 周期数(N)は39, λ =16mmについてはN=29となる。 最終的に、利用実験の要求を満たすために λ =16mm を採用することにより、1-7次高調波によって15keV までのエネルギー領域をカバーした:K=1.05の時、 5次光によって12keVの光子エネルギーを達成。

磁石素材としては、優れた磁気特性ばかりでなく 真空加熱排気時の高温に耐える、Nd-Fe-B系合金 (NEOMAX35VH: Br=12kG,およびiHc=28kOe)を 採用した。真空封止のために磁石表面に5µm厚のTiN コーティングを施した。各磁石を無酸素銅製のホル ダに固定した上で、Al合金製の磁石取り付けビーム 上に配列した。

上記の磁石列は, ステンレス鋼製の真空槽(内面 を電解研磨処理, サイズは内径250mm × 長さ 980mm) に収納される。この真空槽は、Tiゲッタポ ンプとスパッタイオンポンプによって排気される。 磁石ギャップは、4.5mmを最小値として設計したが、 機械的には40mmから3mmまで可変である。ギャッ プ4.5mmでの偏向定数(K)は、λ=16mmの場合1.27 であり、λ=12mmの場合0.72である。電子ビームに よる抵抗ロスおよび寄生モードロスから生じる問題 を避けるために、磁石列の対向面を無酸素銅製の箔 (60µm厚)で覆った。この銅箔にのNiを鍍金 (25µm厚) することにより磁石列へ密着を容易にし た。さらに、可動である磁石列の両端と真空槽内壁 との間をBe-Cu製の箔(180µm厚)で作ったコンタク タによって接続した。このコンタクタは, KEKのPF-AR (6.5GeV) におけるU#NE3真空封止アンジュ レータ(世界初の真空封止型アンジュレータ)で採

用したコンタクタの改良型である[5]。磁石ギャップ が非常に狭い場合に予想される抵抗ロスによる発熱 を避けるためにコンタクタ基底ブロックに水冷パイ プを装着した。SGU#17の内部構造を図3に示した。



図3. 短周期アンジュレータSGU#17の内部構造。

3. 磁場測定および調整

この磁石列に対する磁場調整を精密磁場測定に基づいて行った(図4参照)。この目的でホール素子を用いた精密磁場センサを製作した。このセンサは, 鉛直・水平方向の磁場を同時に測定でき,3mmまでの狭い磁石ギャップに挿入可能である。さらに,室 温領域において0.01℃の精度でホール素子の温度を 制御することが可能である[6]。



図4. 磁場調整中のSGU#17。

磁場調整においては、アンジュレータ各極におけ る電子軌道の蹴り角を調整し、最終的にほぼ理想的 に近い正弦波形の電子軌道が得られるようにした。 アンジュレータ中の電子軌道は、Au=16mmの場合, 図5に示したように非常に良好である。磁場調整は ギャップ5mmにおいて行ったが、磁場の精度は ギャップの可動範囲において保たれている。図5は、 さらに、アンジュレータ出入り口における蹴り角に 関しても非常に満足すべき結果が得られたことを示 している。図5から、これらの蹴り角が絶対値も小さ く、ギャップに伴うそれらの相対的変化も非常に小 さいことが判る。図5においては、アンジュレータ入 り口における蹴り角を積分磁場としてBSENT (Gcm)に よって示した。



図 5. SGU#17の磁場調整の結果のまとめ。 λu=16mmの場合について鉛直(y)および水平(x) 方向の電子軌道として表した。

誤差磁場の影響は、実測磁場から求めた放射の Brillianceが理想磁場に対するそれより劣化する程度 によって明瞭に示すことができるが、今回の結果は、 λ =16mmの場合5次光においても94%もの高い値を維 持している。 λ =12mmの場合は3次光において96%で ある(ともにギャップ5mmの時)。

4. SGU#17の立上げと放射の評価

SGU#17の真空立上げを120℃で行った。48時間の 加熱排気の後、7.5×10⁻¹⁰Torrの真空度を得た。全ての アンジュレータ磁石に対して着磁後磁場調整前に、 磁場安定化のための高温処理を145℃において実行 した。これは120℃での真空立上げ時に、高温減磁 のためにアンジュレータ磁場が劣化するのを防ぐた めである[2, 5]。

SGU#17および付随するビームラインの立上げは, 2005年9月のPF運転再開後順次行われている[1, 7]。 この過程で,我々はSGU#17の磁石ギャップを,電子 ビーム寿命の低下なしに,最小で3.8mmまで閉じら れることを確認した(設計値は4.5mm)。さらに SGU#17のギャップは,PF2.5GeVリングの運転とは 全く独立に自由に(いかなる軌道補正もなしに)変 更可能であることも判明した。これは上述したよう に磁場調整が非常に上手くできたことの効果の一つ である。ギャップの全可動範囲において,鉛直およ び水平方向の軌道変動は5µm以内である。

付随ビームラインにおいて行った放射評価のため のスペクトル測定の結果を図6に紹介する。この測定 では、光源点から17.5m地点に置かれたSi(111)二結晶 分光器で光子のエネルギーを選定し、35m地点に置 かれた2次元スリットによって角度開口の選定を行っ ている。光子数は2次元スリットの後方に置かれたイ オンチャンバによって計測した。二結晶分光器は液 体窒素によって冷却されており、放射光の熱負荷に よる分光結晶の歪みは最小化されている。それでも 微小に残る分光結晶の熱歪みの影響は分光結晶の ロッキングカーブを測定し取り除いた。また分光結 晶の反射率の影響,各種の窓および光路上の大気等 による吸収の影響を補正して,光子数を求めた。2次 元スリットの角度開口は23µrad×23µradである。電子 ビーム電流値は400mAに規格化してある。ここで示 したスペクトルは現在解析継続中の暫定版である。 さらに検討を進めてPFリングの電子ビーム性能の評 価に結びつけたい。比較のために,設計パラメータ に対応する放射スペクトルの計算値も示してある。



図6. SGU#17の放射スペクトル:暫定版。

参考文献

- T. Honda, et al., "Commissioning of the PF Ring after the Reconstruction for the Straight-sections Upgrade", Proc. SRI2006, Daegu, Korea (2006).
- [2] S. Yamamoto, K. Tsuchiya and T. Shioya, "Construction of Two New In-vacuum Type Tapered Undulators for the PF-AR", AIP Conference Proc. 705, 211-214 (2004).
- [3] Y.Kobayashi, Photon Factory Activity Report 2003 #20, 98-100, see also <u>http://pfwww.kek.jp/pfacr/index.html</u>.
- [4] S. Yamamoto, K. Tsuchiya and T. Shioya, "Construction of a Very Short Period Undulator, SGU#17 and the Photon Factory Upgrade", Proc. SRI2006, Daegu, Korea (2006).
- [5] S.Yamamoto et al., "Construction of an In-vacuum Type Undulator for Production of Undulator X Rays in the 5-25keV Region", Rev. Sci. Instrum. 63(1), 400-403 (1992).
- [6] S.Yamamoto et al., "Superbrilliant X-ray Undulator for the Tristan Super Light Facility", Rev. Sci. Instrum. 66(2), 1996-1998 (1995)
- [7] N.Igarashi et al., BL-17A, "A new protein microcrystallography beam line of the Photon Factory", Proc. SRI2006, Daegu, Korea (2006).